

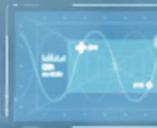
Corporate Profile

通过**技术与对话**, 创造未来

Technology & Tai-wa for Tomorrow

```
M=repZ5eQdA*/  
var prooK5aNextGicM = rXquire(puK4OoaDwexTicKBarqYOV  
B*0K6JZceUst9*X  
  
/B2rep8KcamJTT*/  
val isBrr19 Z reBuirePY3aJrDaH7G  
/~/Sp5a33meW4E9  
  
/~/SpTaB3mRnDQ*/  
Nar: RuBGKc;  
/~/e0LaceFenB7H  
  
HEadaXAV RUfdaTeSate = TTCJabIK5taNeN  
  
/~/LepiaVKmVn8*/  
var EU = FeqMAE(HZ5a33M) ADeX14mUPeUN
```

```
M=repZ5eQdA*/  
var prooK5aNextGicM = rXquire(puK4OoaDwexTicKBarqYOV  
B*0K6JZceUst9*X  
  
/B2rep8KcamJTT*/  
val isBrr19 Z reBuirePY3aJrDaH7G  
/~/Sp5a33meW4E9  
  
/~/SpTaB3mRnDQ*/  
Nar: RuBGKc;  
/~/e0LaceFenB7H  
  
HEadaXAV RUfdaTeSate = TTCJabIK5taNeN  
  
/~/LepiaVKmVn8*/  
var EU = FeqMAE(HZ5a33M) ADeX14mUPeUN
```



KOKUSAI ELECTRIC Way

我们不断追求技术。

在各领域中打磨技术并将其融合，
以此进行创新。

我们始终重视对话。

真诚地保持对话，真挚地面对课题本质，
以此寻找最佳解决方案。

我们将继续通过技术与对话满足多样化的需求，
为不断涌现创造和革新的未来持续提供支持。

我们的技术

- 磨砺技术
- 创新技术
- 以技术迎接挑战
- 展现技术的魅力

Purpose

我们的使命

通过技术与对话, 创造未来

KOKUSAI ELECTRIC集团通过技术与对话，
催生创新，成就未来。

Vision

我们的目标

连接梦想与未来的最佳合作伙伴

Value / Mission

我们的价值观/行动

我们的对话

- 与先进技术的对话
- 与自然环境的对话
- 与社会课题的对话
- 与自身的对话

重要性课题

保持和强化成膜技术的优势， 并支持半导体器件的发展

我们的使命是，用技术和对话为客户与社会做贡献

本集团是专门提供半导体制造设备的全球制造商，专注于半导体器件制造前道工序中的成膜技术。本集团的支柱技术之一是批量ALD*1技术。本集团的ALD成膜设备，可同时实现高难度复杂结构条件下的高质量成膜以及高生产效率，荣居2023年全球市场占有率首位*2。另一项支柱技术是，通过独有的等离子处理产生的润泽的自由基，使其具有出色的各向同性和台阶覆盖性，并以高生产效率实现膜质优化处理技术。2023年，膜质优化处理工艺设备的全球市场占有率为第三位*3。

20世纪50年代，本集团开始着手研发半导体制造设备。至今已致力于研发70余年。20世纪80年代率先研发出全球首个能防止自然氧化膜混入和改善面内均匀性、大幅减少颗粒*4产生的纵型成膜设备。20世纪90年代，我们确立了ALD技术，并且将批量成膜技术和ALD技术相结合，推出了批量ALD技术，此技术作为小型化、多层化、复杂性和三维半导体器件结构不可或缺的技术而受到高度评价，为半导体器件的发展做出了贡献，并显著扩大了集团的业务。我们将继续与客户保持对话，追求如何以高生产效率制作出均匀薄膜，并改良和推进与成膜相关的技术。

我们将通过技术创新来支持半导体器件发展，并为客户和社会做出贡献。这是我们的使命，我们将坚持初心、不负韶华、使命必达。

我们将尽最大努力通过“技术”和“对话”创造价值，并通过“成膜”为社会做出贡献。因此我们想恳请您继续理解和支持。

*1 本集团把采用循环提供多种气体的工序、在原子层级上成膜的方法称为“ALD”。

*2 TechInsights Inc. “TI_ALD Tools - Batch_YEARLY_v24.04” 2024 (April)

*3 Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2023, Bob Johnson, Gaurav Gupta, Menglin Cao, 1, May 2024

膜质优化处理工艺设备:RTP and Oxidation/Diffusion

GARTNER是Gartner Inc.或其关联公司在美国和其他国家(地区)的注册商标和服务标志，我们经该公司许可后使用。All rights reserved. Gartner 不为 Gartner 研究出版物中的任何特定供应商、产品或服务背书。它并非旨在建议技术用户只选择获得最高评级或其他评级的供应商。Gartner Research出版物是发表Gartner Research的见解，并非表述事实。无论明示或暗示，包括本研究的商品性以及对于特定目的的适用性在内，Gartner概不负责。本书中记载的Gartner的内容(以下简称“Gartner内容”)作为Gartner财团订阅服务的一部分，是表述由Gartner, Inc. (以下简称“Gartner”)发行的研究观点或见解，并非表述事实。Gartner内容中的内容均为该Gartner内容发行时的内容，并非本书发行之日的内容。此外，Gartner内容中记载的见解可能会在未经预告的情况下发生变更。

*4 对半导体器件制造工艺产生不利影响的微粒子，主要在数百至数十纳米级别

董事长 社长兼执行董事

金井 史幸

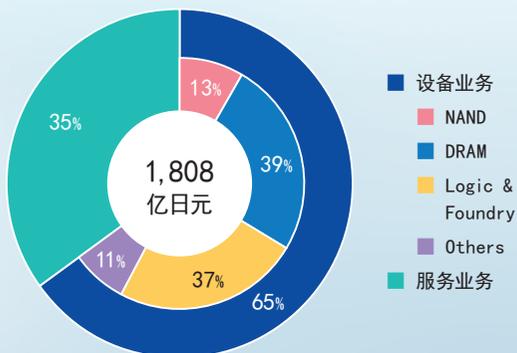


At a Glance

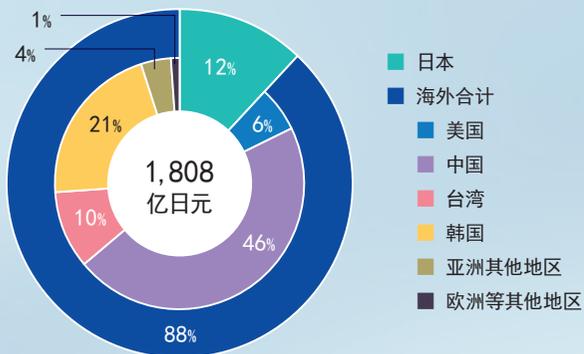
我们专注于“成膜”技术,在设备业务方面,主要产品为支持批量ALD的设备以及膜质优化处理工艺设备,具有全球顶级市场占有率。

财务概况

2024年3月期的各业务/应用程序划分的销售额收益(合并)



2024年3月期的各地区销售额收益(合并)



业务内容

设备业务 (65%)

批量成膜设备

全球市场占有率 No.1 (2023年)*1

批量ALD

- 在批量处理超过数十片晶圆的批量成膜设备中,可支持ALD技术的设备。此类设备随着器件的复杂化,对高难度成膜和高生产效率的要求也越来越高,需求正在不断扩大。
- ALD: Atomic Layer Deposition的缩写。本集团把采用循环提供多种气体的工序、在原子层级别上成膜的方法称为“ALD”。

批量CVD等

- 支持LP-CVD、氧化技术、退火(低温、高温)技术、扩散技术的成膜工艺设备
- CVD: Chemical Vapor Deposition的缩写。该方法同时供应多种气体,通过气相化学反应生成薄膜。本集团重点研究LP-CVD技术: Low Pressure CVD。



膜质优化处理工艺设备

全球市场占有率

No.3 (2023年)*2

- 该设备的目的是,在成膜后,通过等离子体或加热除去薄膜内的杂质,使粒子更加稳定,从而优化膜质。
- 随着器件的复杂化,人们越来越追求各向同性和出色的台阶覆盖性,需求正在不断扩大。低温环境中的膜质改善需求也在增长。



服务业务 (35%)

- 本集团制造和销售的半导体制造设备的售后服务(零部件销售、维护服务、有偿维修、设备装置移机和改造、晶圆尺寸200mm以下的传统设备销售等)。
- 在零部件销售和维修服务方面,从2017年3月期到2023年3月期,在安装基础上达成了与前期相比10%以上的稳步增长。
- 秉持“Design for Service Business”的理念,努力提供具备更高附加值的服务。



*1 出自: TechInsights Inc. “TI_ALD Tools - Batch_YEARLY_v24.04” 2024 (April)

*2 出自: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2023, Bob Johnson, Gaurav Gupta, Menglin Cao, 1, May 2024

膜质优化处理工艺设备: RTP and Oxidation/Diffusion

GARTNER是Gartner Inc.或其关联公司在美国和其他国家(地区)的注册商标和服务标志,我们经该公司许可后使用。All rights reserved. Gartner 不为 Gartner 研究出版物中的任何特定供应商、产品或服务背书。它并非旨在建议技术用户只选择获得最高评级或其他评级的供应商。Gartner Research出版物是发表Gartner Research的见解,并非表述事实。无论明示或暗示,包括本研究的商品性以及对于特定目的的适用性在内,Gartner概不负责。本书中记载的Gartner的内容(以下简称“Gartner内容”)作为Gartner财团订阅服务的一部分,是表述由Gartner, Inc.(以下简称“Gartner”)发行的研究观点或见解,并非表述事实。Gartner内容中的内容均为该Gartner内容发行时的内容,并非本书发行之日的内容。此外,Gartner内容中记载的见解可能会在未经预告的情况下发生变更。

全球网络

日本国内

2家

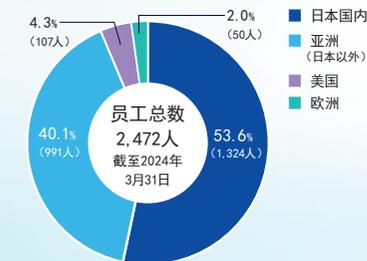
海外

6家

海外员工数(合并)*

46.4%

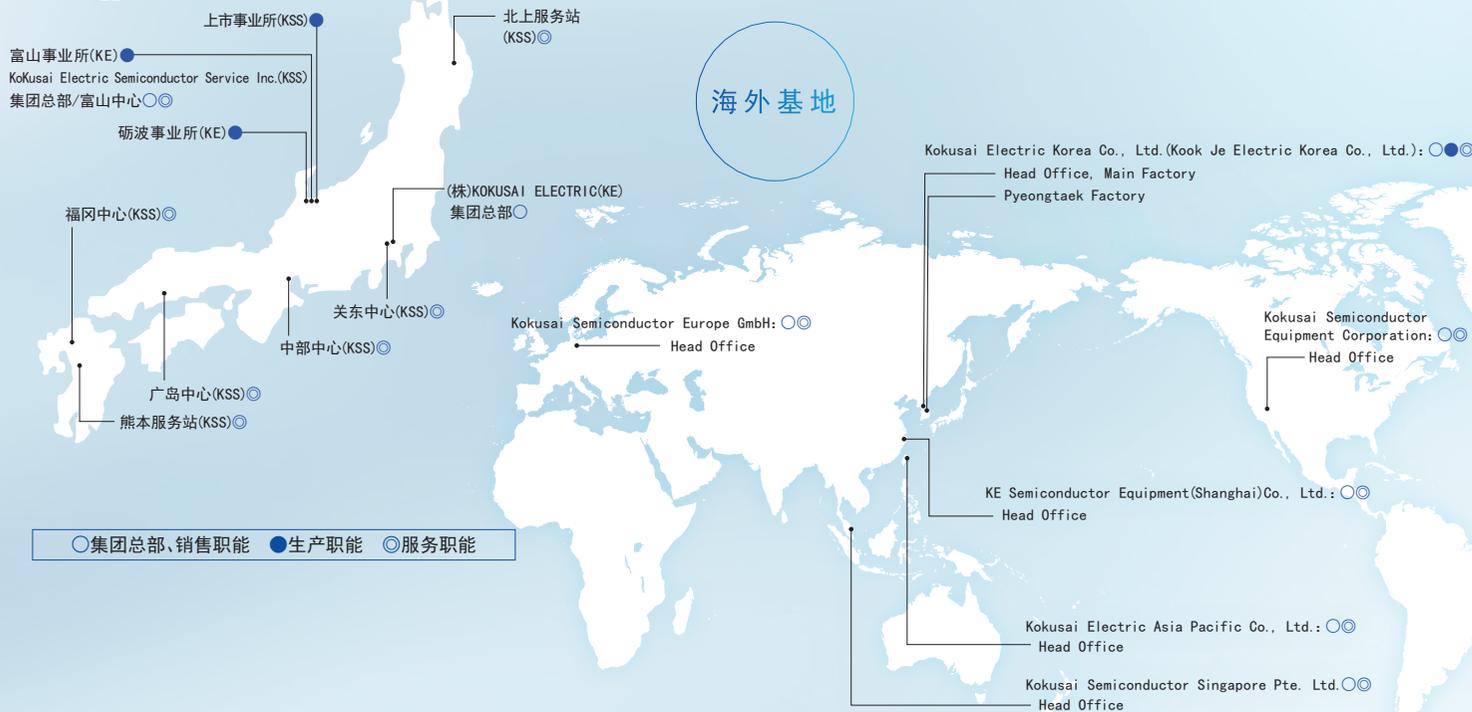
各地区员工比例(合并)*



* 截至2024年3月31日,本集团员工总数为2,472人。其中,海外员工数占比为46.4%。
* 未发生重大员工变动。

日本国内基地

海外基地



主要研发、设计、生产基地

富山事业所

位于遥遥立山连峰的富山市八尾町。在专用的无尘室内研发、设计、生产支持下一代工艺的半导体制造设备等,满足全球大型用户对于最先进的高水平产品的需求。



砺波事业所

2024年9月竣工的全新生产基地。通过引进IoT、DX、生成式AI等先进解决方案,推动向智能工厂转型。位于富山县砺波市,靠近现有的富山事业所,可高效共享供应链和工程师。



Kokusai Electric Semiconductor Service Inc.

上市事业所

坐落在北阿尔卑斯山脉剑岳的山脚下,位于自然环境优美的富山县上市町,从事超声波清洗机、电阻率测量仪的研发、设计、生产以及面向半导体制造设备的控制器的生产,向全球用户提供产品。



Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 天安总部/工厂

位于韩国首都首尔以南约100km处的忠清南道天安市,从事半导体制造设备的设计、生产、改造,以韩国用户为中心提供产品。



Kokusai Electric Korea Co., Ltd. 平泽工厂

位于韩国首都首尔以南的京畿道平泽市。该工厂是面向韩国用户的服务基地,同时进行半导体制造设备的评估和研发,采用当地生产当地消费的方式,满足高水平的技术和产品需求。



中期经营计划

为了正确应对预想中的市场环境和客户需求的变化,并推动向可提高收益的体质转变的措施,我们制定了中长期企业战略和中期业务目标。
此外,关于本集团的经营方针、经营战略,请参照本集团网站。

行业前景的展望

半导体器件的市场规模,相较于2010年的约3,000亿美元,12年后的2022年约为6,100亿美元,增至2倍以上。预计从2023年到2028年,将会以平均增长率9.5%的速度增长*1。使半导体器件市场规模扩大的背景有,智能手机和电脑等电子设备需求的上升,AI、IoT、DX等的推广促进数据中心扩充,针对降低环境影响的投资(GX)等面向产业的需求上升,以及主要国家推行产业支持政策。而目前的世界经济形势是,受不透明的经济环境的影响,智能手机和电脑等电子设备的需求持续低迷,半导体器件制造商持续减少以NAND为中心的投资。但是,半导体器件市场正在调整库存,存储器件的单价开始呈现上升趋势,所以我们认为,2023年前半期的市场行情已经触底。从2024年下半年到2025年,我们预计对半导体器件的需求将正式恢复,面向2027年,通过持续和加快技术革新,回到增长趋势*2。

半导体制造设备的市场规模,相较于2010年的约300亿美元,12年后的2022年约为980亿美元,增至3倍以上。预计从2023年到2028年,将会以平均增长率7.5%的速度增长*2。目前,受不透明的经济环境的影响,半导体器件制造商持续减少以NAND为中心的投资,不过随着半导体器件需求的恢复,半导体制造设备的需求也有望恢复。从中长期来看,半导体器件正在向细微化、结构复杂化、三维化发展,在此背景下,对于能够同时实现高难度成膜和高生产效率的半导体制造设备的需求将会增长。

*1 出自:TechInsights Inc. Semiconductor Forecast (March 24)

*2 出自:TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2018 - 2028) (March 2024)

半导体器件 / 半导体制造设备的全球市场规模(单位:十亿美元)

	2010年	2022年	2023年	2028年(预计)
半导体器件的全球市场规模	296.7	613.9	559.1	878.7
半导体制造设备的全球市场规模	30.4	97.7	99.0	142.3

出自:TechInsights Inc. Semiconductor Forecast (March 2024)

出自:TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST(2018 - 2028)(March 2024)

中长期经营方针

本集团致力于半导体制造工艺前道工序中的“成膜”工序,凭借批量成膜设备、膜质优化处理工艺设备,拥有全球顶级市场占有率。近年来,由于半导体器件正在向细微化、结构复杂化、三维化发展,晶圆表面形状变得复杂,为了形成高质量薄膜等,必须具备更高水平的技术。对此,本集团将利用可同时实现高难度成膜和高生产效率的批量成膜技术以及可在维持高生产效率的同时优化膜质的处理技术,致力于推动高附加值产品的销售拓展和研发,以期扩大业务规模。

此外,在设备的整个生命周期内,根据维护、维修、零部件供应、移机和改造等客户需求,丰富服务项目,同时,致力于扩充生产体制和研发体制,并利用DX提高生产效率,以此应对今后的需求增长。

在我们的ESG措施中,我们将基于一下五个重要课题推进解决问题的活动:①通过创造和革新为社会做贡献、②创造可持续社会并保护地球环境、③人才管理是创新创造的源泉、④加强治理体系以实现可持续发展经营、⑤尊重并关怀人权

具体措施

- 1 持续创造高附加值的技术和产品,着眼于未来10年的研发
- 2 为进一步提升销售额和利润,强化提案能力和客户参与度
- 3 通过在富山县砺波市设立事业所以及采用新型生产方式,使生产效率翻倍
- 4 进一步拓展服务业务
- 5 通过集团一体化经营,不断实施业务活动改革
- 6 为提高收益率,在集团内进一步横向推动业务效率提高
- 7 推动可持续发展经营水平的提升

*详情请参照有价证券报告书。

I 中期企业战略

重点致力于3项战略,努力实现高于WFE*1的事业成长。

- 1 随着NAND、DRAM、Logic/Foundry各应用的复杂化和三维化,本集团扩大销售支持批量ALD*2的设备和膜质优化处理工艺设备
- 2 推动销售面向成熟节点的批量成膜设备和面向发展显著的SiC功率器件的设备,拓宽“成膜”领域的收益基础
- 3 在产品的整个生命周期内,提供可满足客户需求的服务,拓展高收益的服务业务

*1 Wafer Fab Equipment的缩写

*2 本集团把采用循环提供多种气体的工序、在原子层级上成膜的方法称为“ALD”。

短期和中长期的催化剂*3本集团的路线图



*3 本集团推测 *4 Gate All Around *5 Vertical Channel Transistor的缩写 *6 Complimentary Field Effect Transistor

*7 Fin Field-Effect Transistor

I 中期业务目标

本集团以WFE市场规模扩大到1,200亿美元以上为前提,设定了力争在3至4年内达成的中期业务目标。具体目标是,销售额收益达到3,300亿日元以上,调整后营业利润率达到30%以上。各业务销售额构成设想是,设备业务占75%左右、服务业务占25%左右。而设备销售额的各应用销售额构成设想是,Logic/Foundry及其他占50%、DRAM存储器 and NAND存储器共占50%。设备投资从过去的每年20至30亿日元增加到每年40至60亿日元,为了应对半导体器件的发展,我们将每年投入相当于销售额收益6%以上的研发费用。

除此之外,为了从中长期视角提高资本收益性,以此来为实现重视资本成本和股价的经营提供支持,本集团设定了高于WACC(Weighted Average Cost of Capital:加权平均资金成本)的ROIC(Return on Invested Capital:投入资本回报率)和ROE(Return on Equity:净资产收益率)目标。根据我们的披露方针,我们将积极与各位利益相关者进行对话。

	2024年3月期实绩	中期目标
销售额收益	1,808亿日元	3,300亿日元以上
设备业务销售额比例	65%	75%左右
服务业务销售额比例	35%	25%左右
调整后营业利润率	20.9%	30%以上
研发费用(相对于销售额收益的比例)	7.0%	6%以上
(参考)ROE(净资产收益率)	15.7%	25%以上
(参考)ROIC(投入资本回报率)	10.1%	23%以上
(参考)作为前提的WFE市场规模	\$100Bil (2023年)	\$120Bil 以上

I 强化股东回报

- ① 合并股息支付率为20~30%,与日本国内外同行业其他公司处于同等水平
- ② 达成净现金*8后,我们的目标是在偿还有息债务分期付款后分配相当于约70%的自由现金流*9的金额,用于灵活的股票回购和股息
- ③ 合计了股息和股票回购的总回报率预计在中期业务目标达成时约为50%

*8 净现金=现金和现金等价物-有息债务

*9 有息债务分期付款后的自由现金流量=经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量-有息债务的分期赎回

本集团的CSR和可持续发展经营的思路

本集团认为,通过业务活动回应社会的信任和期望是企业的社会责任。

我们的可持续发展经营,在强烈意识到这份社会责任的基础上,从业务活动和ESG(解决环境与社会课题、强化治理)两方面追求经济价值和环境与社会价值,由此在助力达成SDGs的同时,努力兼顾可持续社会的实现和本集团的可持续发展。

本集团通过企业理念、重要性课题(重点考虑的课题)以及运营专业会议体,参加国际倡议等活动基础,推动可持续发展经营。

这些活动的实践状况将通过本报告书和网站等进行公布,作为与各位利益相关者就本集团的可持续发展经营展开广泛对话的材料。



KOKUSAI ELECTRIC集团的企业理念

本集团秉持着KOKUSAI ELECTRIC Way理念,为了兼顾助力达成SDGs和本集团的可持续发展,确定了重要性课题作为要重点考虑的课题,从业务活动和ESG(解决环境与社会课题、强化治理)两方面出发,努力同时实现可持续社会和本集团的可持续发展。

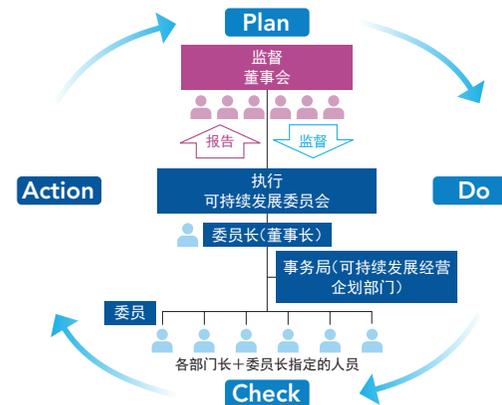


可持续发展委员会

本集团设置并运营可持续发展委员会,作为专门牵头开展可持续发展活动的会议体,由社长担任委员长。

可持续发展委员会由具备解决各类社会课题和事业课题所需的专业性的成员组成。委员会的审议事项是在考虑到重要性课题、外部要求事项等基础上决定的。以委员会为中心的可持续发展活动状况定期向董事会报告,并在公司内部进行通告。

可持续发展活动的推进状况会通过本报告书、本集团网站等进行公布,作为与各位利益相关者就本集团经营展开广泛对话的材料。



价值创造流程

本集团在可持续发展经营的基础[KOKUSAI ELECTRIC Way的实现以及ESG措施(解决环境与社会课题、强化公司治理)]上,基于应解决的重要性课题,通过有效运用经营资本的业务和ESG措施两方面开展活动。我们将通过提供高质量、高性能的产品以及高附加值的服务,来实现一个有助于产业和社会发展、有助于构建可持续社会创造价值的目标。



事业战略

近年来,由于半导体器件结构正在向复杂化、三维化发展,晶圆表面形状变得复杂,为了形成高质量薄膜,必须具备更高水平的成膜技术。此外,形状复杂的高质量成膜十分耗时,因此生产效率被希望进一步提升。对此,本集团将利用可同时实现高难度成膜和高生产效率的批量ALD*技术以及可在维持高生产效率的同时优化膜质的处理技术,致力于推动高附加值产品的销售拓展和研发,以期扩大事业规模。此外,在设备的整个生命周期内,根据维护、维修、零部件销售、移机和改造等客户需求,丰富售后服务项目,同时,致力于扩充生产体制和研发体制,并利用DX提高生产效率,以此应对今后的需求增长。

设备业务的概况

成膜工艺设备

成膜工艺设备是在形成晶圆的电子电路时,形成多晶硅薄膜、绝缘膜等薄膜作为电路材料的设备。支持“ALD”、“LP-CVD”、“氧化”、“扩散”、“退火”等。该成膜工序在形成晶圆上的电路时发挥着重要的作用,因此,对于使各设备提供高水平技术和高可靠性产品来说是必不可少的。作为本集团主力产品的批量成膜设备,受到全球半导体器件制造商的高度评价,其中,支持批量ALD的设备拥有全球顶级市场占有率。

小型批量成膜工艺设备“TSURUGI-C²® 剑[®]”

- 具备支持下一代技术的成膜性能和高生产效率的设备
- 支持最新的批量ALD技术等薄膜形成工艺



大批量成膜工艺设备“AdvancedAce[®]-II”

- 在高难度成膜的基础上实现以大量方式增加处理数量、缩短处理时间的设备
- 支持批量ALD技术、批量CVD技术、氧化技术、扩散技术、退火技术等



膜质优化处理工艺设备

膜质优化处理工艺设备旨在成膜后通过等离子体或加热除去薄膜内的杂质,或使粒子更加稳定,从而优化膜质。本集团制造和销售的膜质优化处理工艺设备包括使用独有的等离子源的氮氧化和膜质优化处理工艺设备、利用非等离子体方式将加热器作为热源的退火设备等。尤其是“MARORA[®]”,对复杂的半导体形状也能进行高生产效率、高质量的膜质优化处理,可以满足半导体器件制造商的大量对此的需求。

单片式膜质优化处理工艺设备“TANDUO[®]”

- 该设备旨在成膜后,通过加热来改善膜质
- 可在低温下进行退火



单片式膜质优化处理工艺设备“MARORA[®]”

- 成该设备旨在成膜后,通过等离子体或加热来优化膜质
- 对于复杂的半导体形状,可以进行高生产效率、高质量的膜质优化处理



QUIXACE[®]-II

- 具备高质量成膜性能和高生产效率的设备
- 支持批量ALD技术、批量CVD技术、氧化技术、扩散技术、退火技术等
- 拥有丰富交货实绩的本集团畅销产品



VERTEX[®] Revolution

- 利用通用平台统一操作性
- 保持维护作业的一贯性
- 通过备件通用化,优化库存成本
- 利用WPS (Wafer Protection System),降低昂贵的SiC晶圆的报废成本

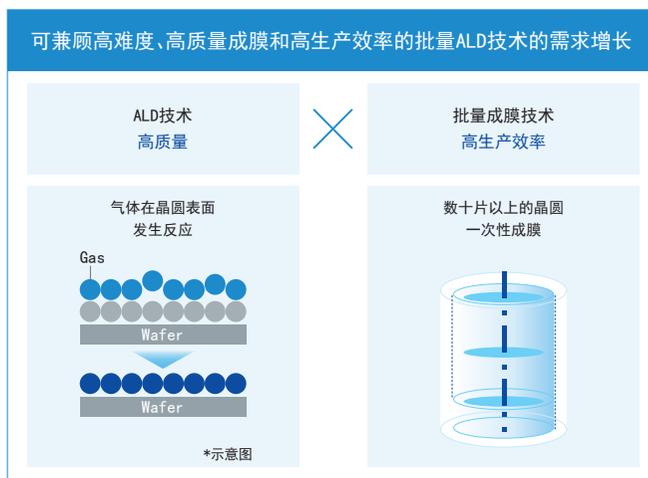
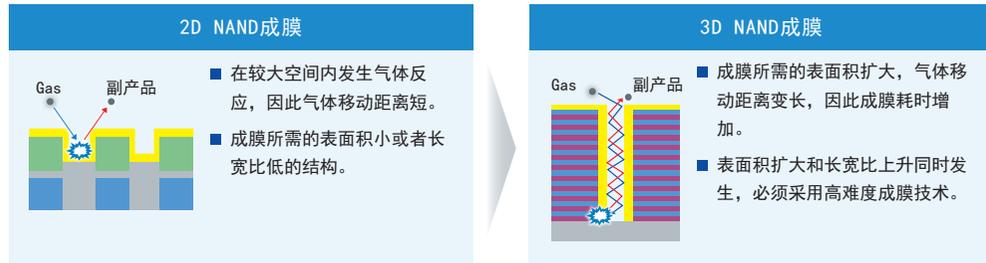


* 本集团把采用循环提供多种气体的工序、在原子层级上成膜的方法称为“ALD”。

本集团的优势

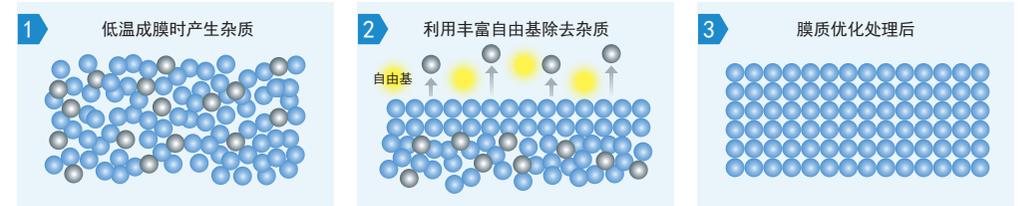
■ 批量ALD*1技术

ALD(Atomic Layer Deposition)技术是一种高难度成膜技术,它可以形成台阶覆盖性好的高质量薄膜,在半导体器件发展的同时,对于该技术的需求也越来越高。该ALD技术循环供应多种气体并进行成膜,因此成膜十分耗时,在生产效率方面存在难题。对此,可对数十片以上晶圆进行一次性成膜的批量成膜技术具备较高的生产效率,是有效的解决方案。本集团的批量ALD技术结合了高质量成膜的ALD技术和对数十片以上晶圆一次性成膜的批量成膜技术,是非常合理的可以同时实现高生产效率和高质量成膜的解决方案。



■ 膜质优化处理技术

所谓膜质优化处理技术,是指在成膜后通过等离子体或加热除去薄膜内的杂质,使粒子更加稳定,从而优化膜质的技术。随着半导体器件日益细微化和复杂化,低温环境下成膜的需求不断增长,处理技术作为可在低温环境中优化膜质的解决方案,需求也在扩大。本集团的处理工艺设备是通过独有的等离子体方式产生丰富自由基,高效地实现膜质优化,使其具有出色的各向同性和台阶覆盖性。



■ 各项应用的应对措施

将在3D NAND方面的领先技术优势推广至DRAM和Logic,努力实现面向NAND、DRAM、Logic/Foundry的各自平衡发展。

Logic/Foundry	<ul style="list-style-type: none"> 在GAA*2方面已获得新研发POR*3。 在GAA第2代方面,TAM*4扩大,努力进一步获得新POR。 在CFET*5方面,随着批量成膜工艺增加(FinFET*6比为1.4倍),努力提高市场占有率。
DRAM	<ul style="list-style-type: none"> 在先进DRAM的高难度成膜方面,已获得新POR。 通过设备进化扩展 TAM,并力进一步获得新POR。 随着3D DRAM的器件结构复杂化,努力提高市场占有率,使其达到与3D NAND相同水平。
NAND	<ul style="list-style-type: none"> 利用大批量成膜工艺设备+小批量成膜工艺设备,在3D NAND成膜工艺方面已获得压倒性的市场占有率。 随着市场行情恢复和器件多层化发展,需求有望增长。

*1 本集团把采用循环提供多种气体的工序、在原子层级上成膜的方法称为“ALD”。

*2 Gate All Around的缩写

*3 POR:Process of Record的缩写,指客户半导体制造工艺中制造设备的认证

*4 Total Addressable Market的缩写

*5 Complementary Field Effect Transistor的缩写

*6 Fin Field-Effect Transistor的缩写

事业战略

服务业务的概况

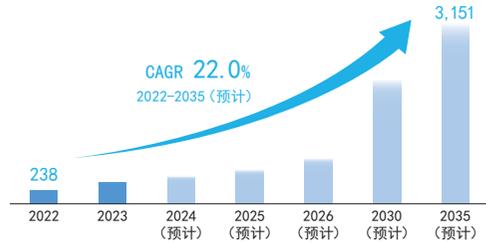
提供本集团制造和销售的半导体制造设备的售后服务,例如维护、维修、零部件销售、设备移机和改造等。半导体生产工厂内,半导体制造设备全年无休地运转。因此,我们不仅供应耐久性高的产品,还提供产品的售后服务,例如维护、维修、零部件销售、设备移机和改造等。此外,除了进行晶圆尺寸200mm以下的设备和中古设备的销售以外,还设立了培训中心,用于讲解设备的维护和操作方法,让客户可以高效率、正确地使用本集团制造的半导体制造设备。



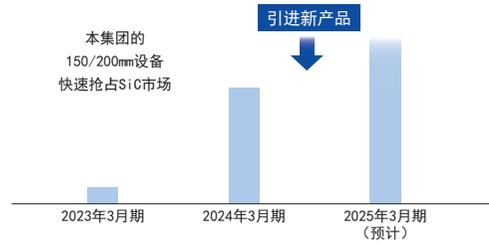
SiC功率器件

在SiC功率器件市场,对于高温活化退火设备的需求有所增长,器件的晶圆尺寸从150mm变为200mm,与此同时,需求也有望扩大。本集团在推动SiC功率器件高温活化退火新产品投入的同时,预计现有产品的销售额将会增加。此外,预计从2026年3月起,高温活化退火新产品的销售额将会增加。

SiC功率器件的市场动向(十亿日元)



SiC相关销售额



High-Temp Activation Anneal (新产品)

- 采用升至极高温的全新加热系统和150/200mm的通用平台
- 预计2025年起开始量产



Topics 关于砺波事业所

在富山县砺波市建设砺波事业所作为新工厂的同时,富山事业所将部分制造职能转移至砺波事业所,并扩充研发职能。由此,与2021年3月期相比,2026年3月期的制造容量将增至约2倍,研发能力将增至1.5倍。同时,将构建能够应对直至2031年3月期的需求增长的体制。

砺波事业所概况

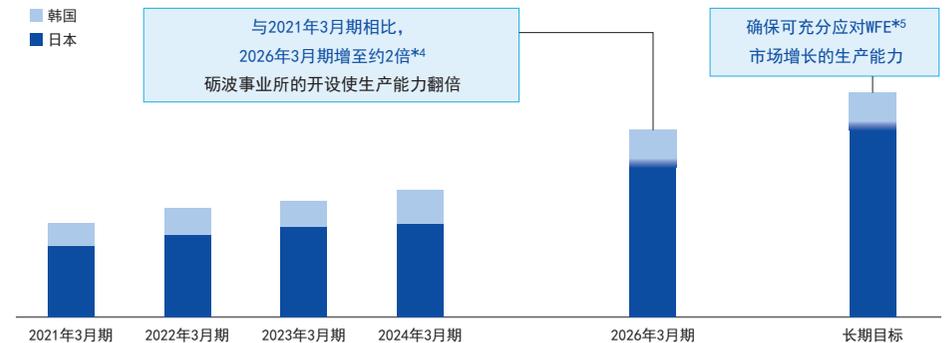


名称	砺波事业所
所在地	富山县砺波市下中条
占地面积	约40,000m ²
投资金额	约240亿日元
用途/建设目的	制造半导体制造设备/提升生产能力以及强化现有的富山事业所的研发体制

砺波事业所SFX200*1理念



加强生产能力

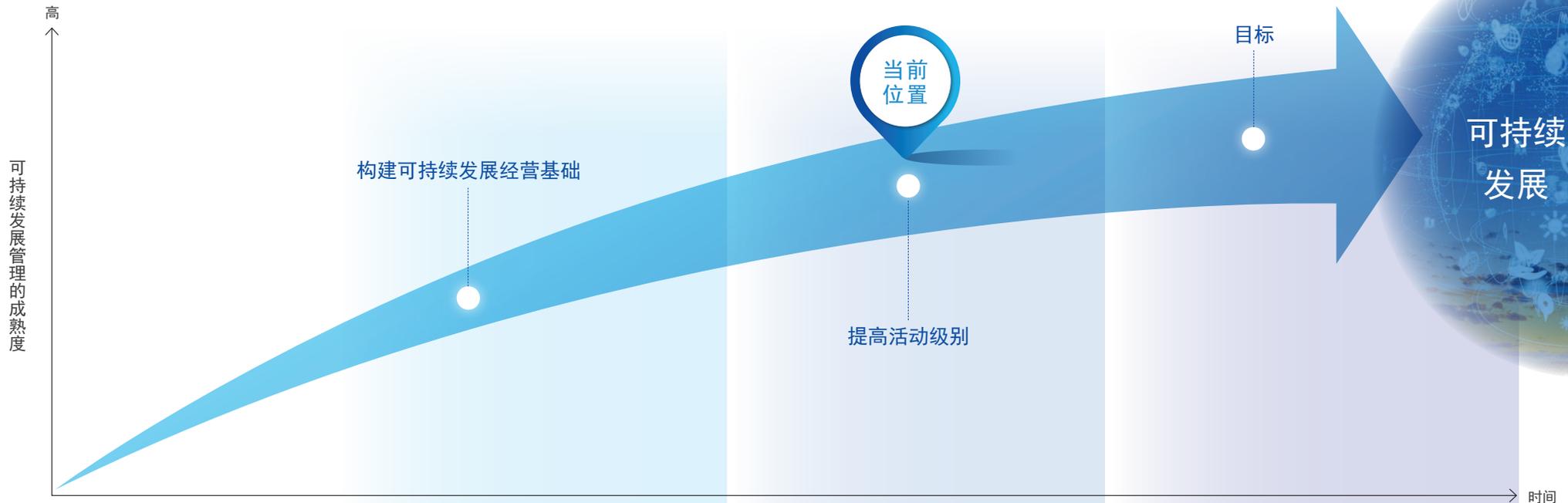


*1 SFX200是Smart Factory Transformation的缩写,指采用各种措施使生产力持续保持在200%(2倍以上)的企理念名称
 *2 SX是Smart Transformation的缩写,指利用IoT/IT/数字化尖端技术和数据的、面向智能生产和管理的变革活动
 *3 指设备安装面积的每固定单位的生产能力。基准是2021年3月期的富山工厂的生产效率比
 *4 本投资计划
 *5 Wafer Fab Equipment的缩写,指半导体制造设备

ESG战略

环境与社会课题解决措施的重要性和关注度不断提升,本集团根据以SDGs为首的日本国内外最新动向,为了构建用于实现实效性公司治理和企业可持续发展的“全球可持续发展治理”,描绘了理想姿态和中长期路线图,在全公司推动相应措施。

对于各类措施,我们均同样重视“KOKUSAI ELECTRIC风格”,基于本集团的优势和应履行的使命,努力实践可持续发展经营,提升企业价值。



提升企业价值的路线图	可持续发展战略	制定企业口号和目的, 确定重要性课题(重点考虑的课题)	针对重要性课题采取措施, 确认进度, 定期调整	实现企业口号和目的, 达成重要性课题KPI
	参与度战略	促进与各利益相关者的“对话/Tai-wa”, 制定参与度方针		确立与各利益相关者的参与度
	披露可持续发展信息	掌握与ESG评估机构、信息披露指南等的外部期待值之间的差距	纳入ESG Index	确立作为ESG优良企业的披露体制
		充实网站、综合报告书、公司治理报告书、有价证券报告书等的信息披露		
可持续发展推进体制	构建和强化全球可持续发展治理体制 (设立和运用可持续发展委员会、向集团公司宣传各项活动等)		确立可持续发展推进体制	

财务概况

4年内的主要财务数据

主要项目	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
销售额收益 (百万日元)	178,023	245,425	245,721	180,838
毛利 (百万日元)	75,951	107,069	100,805	74,965
毛利率 (%)	42.7	43.6	41.0	41.5
营业利润 (百万日元)	60,037	70,652	56,064	30,745
营业利润率 (%)	33.7	28.8	22.8	17.0
税前利润 (百万日元)	50,504	69,264	55,895	29,757
税前利润率 (%)	28.4	28.2	22.7	16.5
归属于母公司所有者的本期利润 (百万日元)	33,043	51,339	40,305	22,374
(参考)调整后营业利润(百万日元)	52,413	79,421	64,251	37,839
(参考)调整后本期利润(百万日元)	31,903	55,566	45,985	27,296
资本合计 (百万日元)	64,943	119,519	160,881	187,388
资产合计 (百万日元)	273,769	356,532	373,539	375,433
有息负债 (百万日元)	125,760	123,191	99,206	93,018
净现金 (百万日元)	△85,721	△14,792	6,847	△399
研发费用 (百万日元)	7,552	9,885	12,425	12,683
设备投资金额 (百万日元)	2,562	3,322	6,568	20,454
折旧费和摊销费 (百万日元)	9,609	10,004	10,304	10,945
经营现金流 (百万日元)	51,127	73,615	29,993	2,942
投资现金流 (百万日元)	△3,312	△3,348	△7,825	△11,950
财务现金流 (百万日元)	△48,317	△3,508	△25,113	△6,312
自由现金流 (百万日元)	47,815	70,267	22,168	△9,008
每股属于母公司所有者的权益 (日元)	281.87	518.75	698.26	811.20
基本每股本期利润 (日元)	143.42	222.83	174.93	96.82
每股股息 (日元)	—	—	—	11.00
股息支付率 (%)	—	—	—	11.4
研发比例 (%)	4.2	4.0	5.1	7.0
自有资本比率 (%)	23.7	33.5	43.1	49.9
(参考)净资产收益率(ROE)(%)	47.3	60.2	32.8	15.7
(参考)投入资本回报率(ROIC)(%)	17.1	25.6	18.3	10.1

* 本集团根据国际财务报告准则 (IFRS) 制作合并财务报表。

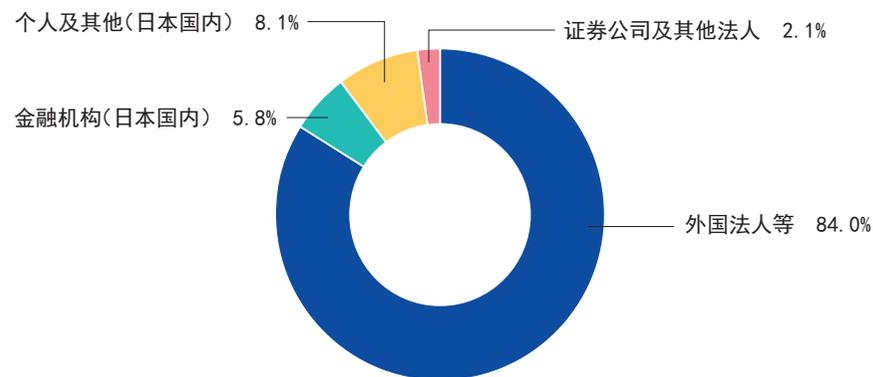
* 关于每股股息和股息支付率, 仅记载上市后的数据。关于2024年3月期的每股股息, 考虑到上市时期是下半年的情况, 采用半年的金额。

企业信息 / 股票状况

企业概况 / 股票相关信息 (截至2024年3月31日)

企业名称	株式会社KOKUSAI ELECTRIC
成立	2017年2月2日
集团总部所在地	〒101-0045 东京都千代田区神田锻冶町3丁目4番地 oak神田锻冶町5楼
资本金	112亿62百万日元
员工数	合并:2,472人 / 单体:1,125人
上市市场	东京证券交易所 主要市场
证券代码	6525
可发行股本总数	900,000,000股
已发行股本总数	232,928,202股
财年	4月1日~次年3月31日
定期股东大会	每年6月
股东确定基准日期	3月31日
期末股息领取股东确定日期	3月31日
期中股息领取股东确定日期	9月30日
每手股数	100股

各所有者股份分布情况 (截至2024年3月31日)



大股东情况 (截至2024年3月31日)

股东名称	持有数(股)	持股比例(%)
KKR HKE Investment L.P.	101,025,800	43.37
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC	34,759,830	14.92
KSP Kokusai Investments, LLC	15,619,500	6.70
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	14,083,454	6.04
Qatar Holding LLC	11,520,000	4.94
日本Master Trust信托银行株式会社(信托账户)	9,803,300	4.20
株式会社日本Custody银行(信托账户)	2,051,000	0.88
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD	1,952,140	0.83
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT	1,506,900	0.64
CEPLUX THREADNEEDLE(LUX)	1,097,900	0.47

* 本集团遵照2024年7月10日公布的“关于股票出售的通知”，出售了大股东KKR HKE Investment L.P.和KSP Kokusai Investments, LLC持有的本集团普通股(60,381,700股)。因此，目前的大股东情况与上述截至2024年3月31日的情况存在较大差异。此外，关于股票出售的详情，请参照本集团网站。

通过**技术**与**对话**, 创造未来



株式会社KOKUSAI ELECTRIC
<https://www.kokusai-electric.com/en>

科意半导体设备（上海）有限公司
<https://kesh.kokusai-electric.com>